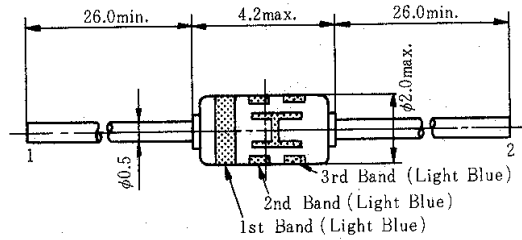


# 1SS149H

シリコンエピタキシャルプレーナ形  
論理回路用

SILICON EPITAXIAL PLANAR  
LOGICAL CIRCUIT



1. カソード : Cathode
  2. アノード : Anode
- (Dimensions in mm)

注) 本体は黒塗装  
(Note) Body is all black.

(JEDEC DO-35)

## ■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項 目	Symbol	1SS149H	Unit
せ ん 頭 逆 電 圧	$V_{R(\text{peak})}$	250	V
逆 電 圧	$V_R$	200	V
平 均 整 流 電 流	$I_O$	150	mA
せ ん 頭 順 電 流	$i_{F(\text{peak})}$	450	mA
サ ー ジ 順 電 流	$I_{F(\text{surge})}^*$	1	A
接 合 部 温 度	$T_j$	175	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	$T_{\text{stg}}$	-65~+175	$^\circ\text{C}$

\*接続時間 1 sec 以内のサージ電流における許容値。

\*Value at duration of 1sec.

## ■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項 目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
順 電 圧	$V_F$	$I_F=100\text{mA}$	—	—	1.0	V
逆 電 流	$I_R$	$V_R=200\text{V}$	—	—	200	nA
端 子 間 容 量	$C$	$V_R=0\text{V}, f=1\text{MHz}$	—	—	10	pF
逆 回 復 時 間	$t_{rr}$	$I_F=30\text{mA}, V_R=10\text{V}, R_L=2\text{k}\Omega$	—	—	5	$\mu\text{s}$